

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年12月9日(2010.12.9)

【公表番号】特表2010-517291(P2010-517291A)

【公表日】平成22年5月20日(2010.5.20)

【年通号数】公開・登録公報2010-020

【出願番号】特願2009-547224(P2009-547224)

【国際特許分類】

H 01 L 33/02 (2010.01)

H 01 L 29/06 (2006.01)

C 01 B 19/04 (2006.01)

H 01 L 29/221 (2006.01)

【F I】

H 01 L 33/00 100

H 01 L 29/06 601N

C 01 B 19/04 C

H 01 L 29/06 601L

H 01 L 29/221

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月19日(2010.10.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子デバイスにおいて使用するためのドープされた半導体輸送層を製造する方法であつて、

(a)コロイド溶液においてインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子を成長させ；

(b)該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子を表面に付着させ；および

(c)該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子の表面から有機配位子がボイルオフするように、該付着したインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子をアニーリングすること、

を含んでなる、方法。

【請求項2】

電子デバイスにおいて使用するためのドープされた半導体輸送層を製造する方法であつて、

(a)コロイド溶液においてインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子を成長させ；

(b)配位子交換を行つて、該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子の表面を、沸点が200℃未満である有機配位子でカバーし；

(c)該配位子交換されたインサイチュでドープされたナノ粒子および有機溶媒を含む分散体を製造し；

(d)該分散体をコーティングして、インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子層を形成し；および

(e)該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子の表面から該交換された有機配位子がボイルオフするように、該付着したインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子層をアニーリングすること、

を含んでなる、方法。